有機・無機ハイブリットペロブスカイト薄膜太陽電池の研究

Development of Organic-inorganic hybrid perovskite thin film solar cells

理工学研究科物質科学部門 石川 良

Graduate School of Science and Engineering Ryo Ishikawa

Abstract

The pore-free and compact $FA_{0.8}Cs_{0.2}PbI_3$ organic-inorganic perovskite films were fabricated by a two-step method using reaction of a porous PbI_2 -(CsI)_{0.2} thin film with FAI 2-propanol solution. The thin films were characterized by XRD, UV-Vis absorption, FESEM, and AFM. The thin films were applied in planar structure solar cells, giving a maximum PCE of 14.7% with V_{oC} of 1.02 V, J_{SC} of 21.4 mA cm⁻², and FF of 67.5 % in reverse scan. Further, uniform surfaces with minimal roughness $FA_{0.8}Cs_{0.2}PbI_3$ thin films by one-step method using 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone having a high boiling point and a low vapor pressure as additive.

1 緒言

近年,再生可能エネルギーが注目を集めており,中でも太陽電池を用いた太陽光発電の導入量 は近年急速に伸びており,その主流は多結晶シリコン太陽電池である.シリコンはクラーク数で2番目 と資源量は豊富であるが,珪石からの還元・精製及び p/n 接合形成プロセスには800℃以上の高温な どが必要で大量のエネルギーを消費している.

光吸収係数が高く溶液プロセスかつ 150℃以下の低温で成膜可能な有機・無機ハイブリッドペロブ スカイト ABX₃(図 1)を光吸収層とするペロブスカイト太陽電池はここ数年で光電変換効率が急速に向 上し最高で 22.1%の光電変換効率が報告されており¹,薄膜太陽電池の中でもトップクラスの性能で 注目を集めており,さらに有機・無機ハイブリッドペロブスカイト薄膜を用いた光・X線検出器²や発光 ダイオードへの応用も期待されている.

有機無機ペロブスカイトの A サイトに CH₃NH₃⁺(MA⁺), B サイトに Pb²⁺, X サイトに Iを用いた MAPbI₃を用いた報 告例が最も多いが, MA⁺には

CH₃NH₃⁺ 与 CH₃NH₂ (沸点-6℃)+H⁺

の平衡があり昇華性の CH₃NH₂が 100℃程度の熱又は真空

中に静置するだけで有機カチオンが脱離し, MAPbI₃ が分解しやすいという問題がある. A サイトが CH(NH₂)₂⁺(FA⁺)の場合には上記のような平衡はなく, FAPbI₃ は MAPbI₃ より耐熱性が優れており, 更 に光学バンドギャップも MAPbI₃ の 1.55 eV から 1.48 eV と小さくなり, 単接合の太陽電池に理想的な バンドギャップ 1.4 eV に近くなる. この FAPbI₃ には空間群 P3m1 で黒色のα体と, 空間群 P63mc で黄 色のδ体の構造異性体が存在し, 室温付近では光電変換特性を示さないδ体が安定である³. FAPbI₃ の A サイトを Cs⁺に部分置換した FA_{1-x}Cs_xPbI₃ は室温でα体が安定であり, 高い耐熱・耐湿性を示し 優れた光電変換特性を示すことから注目を集めている^{4,5}.



図 1 ペロブスカイト構造

2 二段階法によるペロブスカイト薄膜の作成

有機無機ペロブスカイトを N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)やジメチルスルホキシドなどの良溶媒 に溶解し、スピンコート及びアニールして薄膜を作成すると図 2(a)の走査型電子顕微鏡(SEM、日 立 S4800)像のような多数の凝集体や空孔がある膜が得られる.太陽電池は縦方向に動作する デバイスなので、凝集体や空孔は短絡の原因となり好ましくない.そこで図 2(b)のようにスピンコー

ト中にクロロベンゼンやトリフルオロメチ ルベンゼンなどの貧溶媒をスピンコー ト最中に滴下するアンチソルベント法 ^{6,7}と呼ばれる手法により緻密かつ平坦 な多結晶薄膜が得られている.この手 法は技量を必要とし,また大面積化に は向いておらず,更に環境負荷の高 い溶媒を大量に使用するという問題が ある.



図 2 (a) DMF 溶媒から成膜した FA_{0.8}Cs_{0.2}Pbl₃ 薄膜の SEM 像



初めに PbX₂ 薄膜を成膜し, AX 溶液と反応させて ABX₃ 薄膜を形成する二段階法(図 3)により FA_{1-x}Cs_xPbI₃ 薄膜の成膜を試みた. この際, 以下の 2 ルートが考えられる.

 PbI_2 (thin film) + (FAI)_{1-x}(CsI)_x (solution)

 $\rightarrow FA_{1-x}Cs_{x}PbI_{3} \text{ (thin film)}$ (1)

 PbI_2 -(CsI)_x (thin film) + FAI (solution)

 \rightarrow FA_{1-x}Cs_xPbI₃ (thin film)

CsIは, $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ を溶解する DMF やメタノールに可溶で あるが, $FA_{1-x}Cs_xPbI_3$ を溶解しない 2-プロパノールには不溶

(2)

であるので(2)のルートを採用した.また PbI2 は層状物質であり, FAI が PbX2 膜深くまで浸透して 完全に反応し難い事が予想されるので, DMF 溶媒に 4-tert-ブチルピリジン(TBP)を添加して, PbX2-TBP 錯体を一旦形成した後,熱アニールによる錯体の分解により生じる多孔性で AX 溶液 との反応性の高い PbX2 薄膜の利用を検討した⁸.

基板としてフッ素ドープ酸化スズ(FTO)が 300 nm コートされたガラス上に, チタンジイソプロポキ シドビス(アセチルアセトナート)を原料としてスピンコート法で 40 nm の緻密 TiO₂ 層を形成したもの を用いた. 1.2 mol/L PbI₂-(CsI)_{0.2}の DMF 又は DMF:TBP 9:1 v/v 溶液を調製し, UV/O₃ 洗浄した Glass/FTO/TiO₂ 基板上に 2000 rpm, 20 秒でスピコートし 70℃で 10 分アニールした PbI₂-(CsI)_{0.2}



膜の SEM 像が図 4(a), (b)であ る. DMF 溶媒から成膜した PbI₂-(CsI)_{0.2} 薄膜は緻密で層状 構造を示したが, DMF:TBP 混 合溶媒から成膜したものは多数 の空孔を有していた. 両薄膜に 470 mM の FAI 2-プロパノール 溶液を滴下して 3000 rpm, 20

図 4 Pbl₂-(Csl)_{0.2} 薄膜の SEM 像 (a) DMF, (b) DMF:TBP 溶媒

秒でスピンコートして反応させ,表面に残留した過剰のFAIを2-プロパノールで洗い流し,150°C, 10 分アニールした薄膜をX線回折(Bruker D8 Advance Eco),紫外-可視吸収分光(UV-Vis,島 津 UV2600)で評価したのが図 5(a), (b)となる.





DMF 溶媒から成膜した緻密な PbI₂-(CsI)_{0.2} 薄膜からは PbI₂の(100), (210)に帰属される 12.7°, 39.6°のピークが検出され, FAI 溶液と反応後は新たに 14.07°が主ピークのペロブスカイトのα体の ピークが見られるが, 未反応の PbI₂のピークの方が強く現れている.一方, DFM: TBP 溶媒から成 膜した多孔質 PbI₂-(CsI)_{0.2} 薄膜と FAI 溶液を反応させたペロブスカイト薄膜からは PbI₂のピーク は検出されず反応が完全に進行している.これに伴い UV-vis スペクトルでは吸収端はどちらも 810 nm であるが, 吸収端が 530 nm の PbI₂が存在しない多孔質 PbI₂-(CsI)_{0.2} 薄膜から形成した ペロブスカイト薄膜の方が 810~530 nm 間の吸光度が大きい.



図 6 ペロブスカイト薄膜の(a) SEM 像, (b) AFM 像, (c) 太陽電池断面の SEM 像

多孔質 PbI₂-(CsI)_{0.2}薄膜から形成したペロブスカイト薄膜の表面 SEM 像を図 6(a)に, 原子間力 顕微鏡 (AFM) 像を図 6(b)に, 正孔輸送層として 2,2',7,7'-テトラキス(N,N-ジ-p-メトキシフェニルアミ ノ)-9,9'-スピロビフルオレン(Spiro-OMeTAD)をスピンコート成膜し, 銀電極を真空蒸着して作製し た太陽電池の断面 SEM 像を図 6(c)に示す.前駆体の PbI₂-(CsI)_{0.2}薄膜には多数の空孔が存在 したが, FAI 溶液との反応による体積膨張により空孔が埋まり, 緻密な多結晶薄膜が得られた. AFM から求めた平均自乗粗さは 21 nm と比較的平滑であり, 断面 SEM 像からは TiO₂ 層/ペロブ スカイト層, ペロブスカイト層/ Spiro-OMeTAD 層界面には欠陥は存在せず, スムーズな界面であ る.

作製した太陽電池を AM1.5G, 100 mW/cm²の疑似太 陽光照射下で評価した. 測定は順方向(FS -0.5 \rightarrow 1.5 V)と 逆方向(RS 1.5 \rightarrow -0.5 V)にスキャンし, ステップ 10 mV, 遅 延時間 1 ms で行った. 逆方向で開放電圧 V_{oc} 1.02 V, 短絡電流密度 J_{SC} 21.4 mA cm⁻², 曲線因子 FF 67.5%, 光 電変換効率 PCE 14.7%, 順方向で V_{oc} 0.916 V, J_{SC} 20.2 mA cm⁻², FF 53.7%, PCE 9.93%を示した⁹. スキャ ン方向により異なった電流密度-電圧特性を示したが, こ



図 7 ペロブスカイト太陽電池の 疑似太陽光照射下の電流密度-電圧曲線

れはペロブスカイト太陽電池では比較的一般的な問題で,原因としてはペロブスカイト自身の強誘電性,イオン拡散,界面のキャパシタンスなどが挙げられている.

3 一段階法によるペロブスカイト薄膜の作成

これまで二段階法によりペロブスカイト薄膜を成膜してきたが、二段階法ではプロセスが多いので 成膜時間が長くなり、又パラメーターが複雑になるという問題がある. そこで高沸点(286℃)・低蒸気圧 (7 Pa, 25℃) の 1-シクロヘキシル-2-ピロリドン (CHP)¹⁰を DMF 溶媒に少量添加して溶媒蒸発速度を 制御することによりアンチソルベント法を用いること無く、一段階法で緻密で均一なペロブスカイト薄膜 の成膜を目指した. 1 mol/L FA_{0.8}Cs_{0.2}PbI₃ DMF:CHP(CHP=0, 3.5, 7.0, 14 vol%)溶液を Glass/FTO/TiO₂ 基板上に 4000 rpm, 50 秒でスピンコートし 170℃で 10 分アニールした SEM 像が図 2(a)および図 8(a)~(c)となる. CHP の最適添加量 7.0 vol%で図 8(b)の空孔がなく緻密な多結晶薄膜 が得られた.



図8ペロブスカイト薄膜の SEM像 (a) CHP 3.5 vol%, (b) CHP 7.0 vol%, (c) CHP

この薄膜を太陽電池に適用したところ逆方向で V_{oc} 1.08 V, J_{sc} 19.1 mA cm⁻², FF 69.0%, PCE 14.2%, 順方向で V_{oc} 0.978 V, J_{sc} 18.9 mA cm⁻², FF 49.8%, PCE 9.20%と二段階法とほぼ同等の性能が得られた.

4 まとめ

前駆体として多孔質 PbI₂-(CsI)_{0.2} 薄膜を用い FAI 溶液と反応させることにより未反応の PbI₂ が存在 しない緻密な FA_{0.8}Cs_{0.2}PbI₃ 薄膜を成膜した.これを薄膜太陽電池に応用したところ逆方向スキャン 時に光電変換効率 14.7%が得られた.また高沸点・低蒸気圧の 1-シクロヘキシル-2-ピロリドンを適量 添加することにより一段階法で均一かつ緻密な FA_{0.8}Cs_{0.2}PbI₃ 薄膜を作製し,こちらも光電変換効率 として 14.2%と二段階法とほぼ同等の特性が得られた.

5 参考文献

- 1. W.S. Yang, B.-W. Park, E.H. Jung et al., Science. 356 (2017) 1376
- 2. S. Shrestha, R. Fischer, G.J. Matt et al., Nature Photonics. 11 (2017) 436
- 3. C.C. Stoumpos, C.D. Malliakas, M.G. Kanatzidis, Inorganic Chemistry. 52 (2013) 9019
- 4. J.W. Lee, D.H. Kim, H.S. Kim et al., Advanced Energy Materials. 5 (2015) 1501310.
- 5. Z. Li, M. Yang, J.-S.S. Park, S.-H.H. Wei et al., Chemistry of Materials. 28 (2016) 284
- 6. M. Xiao, F. Huang, W. Huang et al., Angewandte Chemie International Edition. 53 (2014) 9898
- 7. S. Paek, P. Schouwink, E.N. Athanasopoulou et al., Chemistry of Materials. 29 (2017) 3490.
- 8. H. Zhang, J. Mao, H. He, D. Zhang, et al., Advanced Energy Materials. 5 (2015) 1501354.
- 9. R. Ishikawa, K. Ueno, H. Shirai, Chemistry Letters. 46 (2017) 612.
- 10. Y.-J. Jeon, S. Lee, R. Kang et al., Scientific Reports. 4 (2014) 6953.